This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-017531

(43)Date of publication of application: 20.01.1998

(51)Int.CI.

C07C211/54
B01J 31/24
C07C209/10
C07C209/60
C07C211/56
C07C211/58
C07C211/59
C07C213/02
C07C217/92
C07F 5/02
// C07B 61/00

(21)Application number: 08-176226

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

05.07.1996

(72)Inventor: SATO TADAHISA

(54) PRODUCTION OF AROMATIC TERTIARY AMINE COMPOUND AND ITS SYNTHETIC INTERMEDIATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject compound useful as an organic electroluminescent material, an electrophotographic material, etc.; in high yield readily by a cross coupling reaction between carbon atoms of an aromatic group using a palladium catalyst.

SOLUTION: A cross coupling reaction is carried out between carbon atoms of an aromatic group by using a palladium catalyst, for example, a compound of formula I (Ar1 and Ar2 are each an aromatic group; X1 is a halogen, an alkane or an allenesulfonyloxy; Ar1 and Ar2 may be bonded to form a ring; R1 is a substituent group; (I) is 0-4) and a compound of formula II (Ar3 is a monofunctional to hexafunctional aromatic group; X2 is a group to be bonded by Mg, Zn, B, Cu, Al, Si or Sn; (m) is 1-6) are subjected to cross coupling to give a compound containing two or more aromatic amines and at least one aromatic hydrocarbon-based ring collected group.

$$A_{\lambda_1}$$
 $N \longrightarrow X_{\lambda_1}$

$$(A r^3 - (X^2)_n$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Searching PAJ

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

2004/04/26

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-17531

(43)公開日 平成10年(1998) 1月20日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
C 0 7 C 211/54		8828-4H	C 0	7 C 21	1/54			
B 0 1 J 31/24			B 0	1 J 3	1/24		X	
C 0 7 C 209/10		8828-4H	C 0	7 C 20	9/10			
209/60		8828-4H		20	9/60			
211/56		8828-4H		21	1/56	٠		
		審査請求	未請求	請求項	の数10	OL	(全 44 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-176226		(71)	出願人	000005	201		
					富士写	真フイ	ルム株式会社	
(22)出願日	平成8年(1996)7	月5日			神奈川	県南足	柄市中沼210番	钟
			(72)	発明者				
								計 富士写真
					フイル	ム株式:	会社内	
					,			

(54) 【発明の名称】 芳香族三級アミン化合物の製造方法及びその合成中間体

(57)【要約】

【課題】種々の置換基を有する芳香族第三級アミン化合物の製造方法を提供する。

【解決手段】分子内に少なくとも2つの芳香族三級アミンを有し、かつ少なくとも1つの芳香族炭化水素環系環集合基を有する化合物を合成する際に、パラジウム触媒を用いた芳香族基の炭素原子間クロスカップリング反応を用いる芳香族三級アミン化合物の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子内に少なくとも2つの芳香族三級アミンを有し、かつ少なくとも1つの芳香族炭化水素環系環集合基を有する化合物を合成する際に、パラジウム触媒を用いた芳香族基の炭素原子間クロスカップリング反応を用いることを特徴とする芳香族三級アミン化合物の製造方法。

【請求項2】 一般式(I)で表わされる化合物と一般式(II)で表わされる化合物をクロスカップリングすることを特徴とする請求項(1)記載の芳香族三級アミン化合物の製造方法。

【化1】

$$Ar^1$$
 N 一般式 (I)

(式中、 Ar^1 および Ar^2 は芳香族基を表し、 X^1 は ハロゲン原子又はアルカンもしくはアレンスルホニルオキシ基を表わす。 Ar^1 と Ar^2 は結合して環を形成してもよい。 R^1 は置換基を表わし、1は0ないし4の整数を表わす。)

【化2】

(A r ³) (X ²)_m 一般式(II)

(式中、Ar³ は1~6価の芳香族基を表わし、X² はマグネシウム、亜鉛、銅、ホウ素、アルミニウム、ケイ素又はスズ元素で結合する基を表わす。mは1ないし6の整数を表わす。)

【請求項3】 一般式(III) で表わされる化合物と一般式(IV)で表わされる化合物をクロスカップリングすることを特徴とする請求項(1)記載の芳香族三級アミン化合物の製造方法。

【化3】

 Ar^{0} N Ar^{0} 一般式 (VI) Ar^{10} N Ar^{11} Ar^{12}

(式中、 Ar^8 、 Ar^9 、 Ar^{10} 、 Ar^{11} 、 Ar^{12} 、および Ar^{13} は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わす。qは1以上の整数を表わす。)

【請求項7】 製造する芳香族三級アミンが一般式(VI

(式中、 Ar^1 、 Ar^2 、 R^1 、および 1 は前記一般式 (I) で定義した基および数と同義であり、 X^2 は前記 一般式 (II) で定義した基と同義である。)

【化4】

(Ar³→ (X¹)_m 一般式(IV) (式中、Ar³ およびmは前記一般式(II)で定義した 基および数と同義であり、X¹ は前記一般式(I)で定 義した基と同義である。)

【請求項4】 クロスカップリング反応に作用する触媒が0価のパラジウム金属錯体であることを特徴とする請求項1、2又は3記載の芳香族三級アミン化合物の製造方法。

【請求項5】 製造する芳香族三級アミンが一般式 (V) であることを特徴とする請求項1、2、3又は4 記載の製造方法。

【化5】

$$Ar^4$$
 N Ar^5 N Ar^7 一般式 (V)

(式中、Ar⁴、Ar⁵、Ar⁶およびAr⁷は置換もしくは無置換のフェニル、又はナフチル基を表わす。R²は、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、又はジアルキルアミノ基を表わす。nは2以上の整数、pは0ないし4の整数を表わす。)

【請求項6】 製造する芳香族三級アミンが一般式 (VI) であることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の製造方法。

【化6】

I)であることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の製造方法。

【化7】

(式中、Ar¹⁴、Ar¹⁵、Ar¹⁶、Ar¹⁷、Ar¹⁸、およびAr¹⁹は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わす。rは2以上の整数を表わす。)

【請求項8】 製造する芳香族三級アミンが一般式(VIII)であることを特徴とする請求項5記載の製造方法。 【化8】

(式中、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、および R^{10} は置換もしくは無置換のアルキル基を表し、sは2ないし4の整数を表わす。)

【請求項9】 一般式 (IX) で表わされる化合物。 【化9】

(式中、R¹¹およびR¹⁴は水素原子又は低級アルキル基、R¹²およびR¹³は水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、低級ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、低級ア

ルコキシ基又はニトロ基を表わす。) 【請求項10】 一般式(X)で表わされる化合物。 【化10】

(式中、R¹⁵およびR¹⁸は水素原子又は低級アルキル基、R¹⁶およびR¹⁷は水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、低級アルコキシ基、低級

ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又はニトロ基を表わす。 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} がすべて同時に水素原子であることはない。又、R

¹⁶とR¹⁷が同時に低級アルキル基であることはない。) 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス(EL)材料、又は電子写真用材料、又は光記録材料用などの近赤外染料用原料として有用な芳香族三級アミン化合物の製造方法及びその合成中間体に関する。詳しくは、パラジウム触媒を用いた芳香族基の炭素原子間クロスカップリング反応を用いた分子内に少なくとも2つの芳香族三級アミンを含む化合物の高収率製造方法及び、この反応に有用な合成中間体に関する。

[0002]

【従来の技術】バンスライクおよびタンらは例えば米国 特許第4,539,507号、同第4,720,432 号、特開平5-234,681号においてフェニル基、 フェニレン基、又はビフェニレン基を含む芳香族第三級 アミンを内部接合有機EL装置の正孔注入・輸送帯域に 使用すると光出力の安定性が向上し、それによって動作 寿命が延びることを明らかにした。その後更なる光出力 の安定性を計るためにこの正孔注入輸送帯域に用いる芳 香族第三級アミンの改良は多くの研究者により試みら れ、多くの特許出願および学術文献への報告がなされて いる。その例をあげればビフェニル系の第三級アミンに 関して Japanese Journal of Applied Physics, 27,L 269(1988) 、特開昭59-194393号、Appl. Phys. Lett.66,2679(1995)、特開平5-234681号、同7 -331238号、同8-48656号、およびWO9 5/09147号など、スダーバースト系の第三級アミ ンに関して、Appl.Phys.Lett.65,807(1994) 、特公平7 -110940号などがある。

【0003】電子写真用材料としても芳香族第三級アミンは重要であり、正孔輸送材への利用が特許出願されており、例えば特開昭58-32372号、同63-235946号、特開平1-142657号があげられる。そして、既に小型の普通紙コピー機には芳香族第三級アミン化合物が実用されており、安価なコピー機の普及に貢献している。

【0004】また、ジアルキルアミノ基を共役位に有する芳香族第三級アミンは、その酸化体が光記録材料用などの近赤外染料などとして有用であることが、例えば米国特許3,484,467号、同3,575,871号、特開平6-321872号に開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このように、種々の用途に芳香族第三級アミンは有用な化合物であるが、それらの中のビフェニル基などを有するポリフェニル系芳香族第三級アミンの合成方法は、主にウルマン型反応を用いる方法が常法であった(米国特許4,764,625号)。この方法は、銅触媒を用い、塩基性条件下でハロゲン化アリール(主にヨウ化アリール)とジアリールア

ミンを反応させて、炭素-窒素結合を結合させることを 特徴とする。この方法は単純な芳香族第三級アミンを合 成する場合には有効な方法であるが、高温(>160 ℃)かつ、長時間を要する反応であるため、出発物質や 生成物が、熱や塩基に不安定な場合には利用できなかっ た。また一般に反応時間が長く収率が低く、高純度品が 得るための精製が容易でないなど生産性が低いことも問 題であった。最近城田らは、グリニャール試薬と二価の ニッケル錯体を用いて、芳香族三級アミンを分子内に有 する化合物の合成法を開示しているが (特開平7-53 955号、J.Mater.Chem., 2, 1109(1992)) ニッケルは近年その発ガン性が問題となっており、工業 的規模での製造では使用しにくい金属触媒である。更に 近赤外吸収染料用のビフェニル基を有する芳香族第三級 アミンの合成には、強い発ガン性により、製造禁止物質 になっているベンジジンを用いなければならないことも 大きな問題であった(米国特許公報3,484,467 号、特開平6-321872号)。

【0006】本発明が解決しようとする課題は、ビフェニル基のような多環系環集合基と少なくとも2つの芳香族第三級アミンを分子内に有する化合物の合成の困難さであり、発明の目的は、穏やかな条件下で、安全性に問題がある原料を用いることなく、種々の置換基を有する前記芳香族第三級アミン化合物の製造方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討した 結果、パラジウム触媒を用いた芳香族基の炭素原子間クロスカップリング反応を用いることにより、前記の目的 が達成できることを見出し、その知見に基づき、本発明 をなすに至った。

【0008】すなわち、本発明は

(1)分子内に少なくとも2つの芳香族三級アミンを有し、かつ少なくとも1つの芳香族炭化水素環系環集合基を有する化合物を合成する際に、パラジウム触媒を用いた芳香族基の炭素原子間クロスカップリング反応を用いることを特徴とする芳香族三級アミン化合物の製造方法。

(2) 一般式(I)で表わされる化合物と一般式(II)で表わされる化合物をクロスカップリングすることを特徴とする上記(1)記載の芳香族三級アミン化合物の製造方法。

[0009]

【化11】

$$Ar^1$$
 N 一般式 (I)

【0010】(式中、Ar¹ およびAr² は芳香族基を表し、X¹ はハロゲン原子又はアルカンもしくはアレン

スルホニルオキシ基を表わす。 $Ar^1 \& Ar^2$ は結合して環を形成してもよい。 R^1 は置換基を表わし、I は0 ないし4 の整数を表わす。)

[0011]

【化12】

【0012】(式中、 Ar^3 は $1\sim6$ 価の芳香族基を表わし、 X^2 はマグネシウム、亜鉛、銅、ホウ素、アルミニウム、ケイ素又はスズ元素で結合する基を表わす。m は1ないし6の整数を表わす。)

【0013】(3)一般式(III)で表わされる化合物と一般式(IV)で表わされる化合物をクロスカップリングすることを特徴とする上記(1)記載の芳香族三級アミン化合物の製造方法。

[0014]

【化13】

【0015】(式中、 Ar^1 、 Ar^2 、 R^1 および 1 は 前記一般式(I) で定義した基および数と同義であり、 X^2 は前記一般式(II) で定義した基と同義である。)

【化14】

(Ar³) (X¹)_m 一般式(IV) 【0017】(式中、Ar³ およびmは前記一般式(I

Ar¹⁰

Ar¹¹

Ar¹¹

Ar¹²

【0023】(式中、Ar⁸、Ar⁹、Ar¹⁰、Ar¹¹、Ar¹²およびAr¹³は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わす。 qは1以上の整数を表わす。)

【0024】(7)製造する芳香族三級アミンが一般式

I)で定義した基および数と同義であり、X¹ は前記一般式(I)で定義した基と同義である。)

(4) クロスカップリング反応に作用する触媒が0価の パラジウム金属錯体であることを特徴とする上記

(1)、(2)又は(3)記載の芳香族三級アミン化合物の製造方法。

【0018】(5)製造する芳香族三級アミンが一般式(V)であることを特徴とする前記(1)、(2)、

(3) 又は(4) 記載の製造方法。

[0019]

【化15】

$$Ar^4$$
 N Ar^6 N Ar^7 一般式 (V)

【0020】(式中、Ar⁴、Ar⁵、Ar⁶およびAr⁷は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わす。R²は、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基又はジアルキルアミノ基を表わす。nは2以上の整数、pは0ないし4の整数を表わす。)

【0021】(6) 製造する芳香族三級アミンが一般式(VI) であることを特徴とする請求項(1)、(2)、

(3)又は(4)記載の製造方法。

-般式(VI)

[0022]

【化16】

(VII)であることを特徴とする上記(1)、(2)、(3)又は(4)記載の製造方法。

[0025]

【化17】

【0026】(式中、 Ar^{14} 、 Ar^{15} 、 Ar^{16} 、 Ar^{17} 、 Ar^{18} および Ar^{19} は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わす。rは2以上の整数を表わす。)

y。/ 【0027】(8)製造する芳香族三級アミンが一般式 (VIII)であることを特徴とする上記 (5) 記載の製造方法。

【0028】 【化18】

【0029】(式中、R³、R⁴、R⁵、R⁵、R⁷、 R⁸、R⁹およびR¹⁰は置換もしくは無置換のアルキル 基を表し、sは2ないし4の整数を表わす。) 【0030】(9)一般式(IX)で表わされる化合物。 【0031】 【化19】

【0032】(式中、R¹¹およびR¹⁴は水素原子又は低級アルキル基、R¹²およびR¹³は水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、低級ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、低級アルコキシ基又はニトロ基を表わす。)

【0033】(10) ―殷式(X) で表わされる化合物。

【0034】 【化20】

$$\begin{array}{c|c}
R^{16} & & \\
\hline
& & \\
R^{17} & & \\
R^{18} & & \\
\end{array}$$

一般式(X)

【0035】(式中、R¹⁵およびR¹⁸は水素原子又は低級アルキル基、R¹⁶およびR¹⁷は水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、低級アルコキ

シ基、低級ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の ジフェニルアミノ基又はニトロ基を表わす。 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} がすべて同時に水素原子であることは ない。又、R¹⁶とR¹⁷が同時に低級アルキル基であることはない。)を提供するものである。

[0036]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳しく説明 する。

【0037】まず、芳香族炭化水素環系環集合基について説明する。環集合 (ring assenblies)の定義は「二つ以上の環系が一重結合か二重結合で直結していて、環を直結している結合の数が環系の数より一つだけ少ないもの」(平山健三、平山和雄「有機化学・生化学命名法」改訂第2版、上巻、39頁、1988年、(株)南

光堂)であり、芳香族炭化水素環系環集合とは、上記定義の環系が芳香族炭化水素環である環集合をさす。そして芳香族炭化水素環系環集合基とは、芳香族炭化水素環系環集合の水素原子をいくつか除いて誘導できる1価および多価の基をさす。

【0038】芳香族炭化水素環系環集合基について、代表的具体例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

【0039】 【化21】

【0040】次に一般式(I)~(VII)の置換基について説明する。 Ar^1 および Ar^2 は芳香族基を表わすが、詳しくは炭素数6~50の非縮合もしくは縮合多環系炭素環又は複素環芳香族基である。これらの具体例をあげれば、フェニル、3ービフェニルイル、4ービフェニルイル、pーテルフェニルー4ーイル、pークアタフェニルー4ーイル、1ーナフチル、2ーナフチル、7ー(2ーナフチル)-2ーナフチル、4ー(1ーナフチル)-1ーナフチル(2ーナフチル)-1ーナフチルもしくは6ー(2ーアントリル)-2ーナフチルなどの非縮合もしくは縮合炭素環芳香族基、又は2ーピリ

ジル、4ーピリジル、4ーキノリル、8ーキノリル、1ーアリリジニル、1, 10ーフェナントロリンー2ーイルもしくは4ー(4ーピリジル)-2ーピリジルなどの非縮合もしくは縮合複素環芳香族基である。好ましくはAr¹ およびAr² は非縮合もしくは縮合炭素環芳香族基であり、特に好ましくはフェニル、4ーピフェニルイル、1ーナフチルもしくは2ーナフチル基である。

【0041】Ar¹ およびAr² が置換基を有する場合、その置換基としてはハロゲン原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、スルホ基、アミノ基、アルコキシ

基、アリールオキシ基、アシルアミノ基、アルキルアミノ基、アニリノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニルを、オスホニル基、アリールオキシカルボニル基、アシル基、シリル基又はアゾリル基が挙げられる。好ましい置換基はアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ジアルキルアミノ基、ジアリールアミノ基又はNーアルキルーNーアリールアミノ基である。尚、Ar¹とAr²は互いに結合し、カルバゾリルやフェノキサジニル基などの環を形成してもよい。

【0042】Ar³ は1~6価の芳香族基を表わすが、 詳しくは炭素数6~60の炭素環又は複素環芳香族化合 物由来の1~6価の芳香族基を表わす。具体的にはフェ ニル、oー、mー、もしくはpーフェニレン、ベンゼン -1, 3, 5- ν , τ 4, 5, 8-テトライル、ペリレン-3, 4, 9, 10 ーテトライル、ビフェニルー4, 4'ージイル、pーテ ルフェニルー4, 4' ージイル、2, 1':5', 2''ーテルナフタレン-5,5"ージイル、1,3,5ート リフェニルベンゼンー4′,4″,4′′′ートリイ ル、トリフェニルアミン-4,4',4"-トリイルも しくはフェニルー1, 2, 3, 4, 5, 6 - ヘキサイ ル、などの炭素環芳香族基、又は、2-ピリジル、3-ピリジル、4ーピリジル、ピリジン-2,6ージイル、 ピリジン-2, 4-ジイル、4-キノリル、ピラジン-2, 5-ジイル、キノリン-4, 8-ジイル、フェナジ ルー1, 4, 6, 9ーテトライルイミダゾ〔2, 1b) チアゾール-3, 5-ジイルもしくは、フタラジン -1,4-ジイルなどの複素環芳香族化合物である。好 ましくは1~3価の炭素環芳香族基であり、特に好まし くはフェニル、oー、mーもしくはpーフェニレン、ベ ンゼン-1,3,5-トリイル、ビフェニル-4,4' ージイル、1,3,5ートリフェニル、ベンゼンー 4′, 4″, 4′′′ートリイル、又はトリフェニルア ミンー4,4',4"ートリイルの炭素環芳香族基であ

【0043】 Ar^3 は X^1 又は X^2 以外の置換基を有してもよく、置換基および好ましい置換基としては、前記 Ar^1 および Ar^2 が有する置換基と同義の基があげられる。

【0044】X¹ はハロゲン原子又はアルカンもしくは アレンスルホニルオキシ基を表わすが、具体的には塩 素、臭素又はヨウ素の各原子、およびメタンスルホニル オキシ、ベンゼンスルホニルオキシ、トリフルオロメタ ンスルホニルオキシ又は、ペンタフルオロベンゼンスルホニルオキシ基を表わす。好ましくは臭素、ヨウ素原子 又はトリフルオロメタンスルホニルオキシ基であるが、 特に好ましくはヨウ素原子である。

【0045】X² はマグネシウム、亜鉛、銅、ホウ素、 アルミニウム、ケイ素又はスズ元素で結合する基を表わ すが、詳しくは-Mg X³、-Zn X⁴、-Cu X⁵、 $-Cu-B(Y^{1})_{2}$, $-Al(Y^{2})_{2}$, $Si(Y^{3})_{3}$ XはSn (Y4)₃ で表わされる基である。X³ 、X⁴ 、X 5 はハロゲン原子を表わし、好ましくは塩素、臭素又は ヨウ素原子を表わし、特に好ましくは塩素又は臭素原子 である。 $Y^1 \setminus Y^2 \setminus Y^3$ および Y^4 はハロゲン原子、 アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、又はヒ ドロキシル基であり、好ましくはフッ素、塩素もしくは 臭素原子のハロゲン原子、メチル、エチル、n-ブチ ル、もしくはi-ブチルのアルキル基、メトキシ、エト キシ、イソプロピルオキシもしくはエチレンジオキシの アルコキシ基、フェノキシもしくは1,2-フェニレン ジオキシのアリールオキシ基又はヒドロキシル基であ る。Y¹、Y²、Y³ およびY⁴ は特に好ましくは塩素 原子、n-ブチル基又はヒドロキシル基である。尚、Y 1~Y4 は2~3個が各元素に結合するが、それらが常 に同一の基であるとは限らず、Y1 ~Y4 で定義された 異なった基が1つの元素に結合していてもよい。

【0046】 X^2 は好ましくは $-ZnX^4$ 、 $-B(Y^1)$ 2 又は $Si(Y^3)_3$ であり、特に好ましくは-ZnC 1、 $-B(OH)_2$ 、 $-Si(CH_3)_3$ 又は $-SiCH_3$ C 1_2 である。

【0047】R1 は置換基を表わすが、具体的にはハロゲン原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、スルホ基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルアミノ基、アルキルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アゾ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、ホスホニル基、アリールオキシカルボニル基、アシル基、シリル基、スレフィニル基、シリル基を表わす。

【0048】さらに詳しくは、R1 はハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子)、アルキル基(例えば、炭素数1~32の直鎖、または分岐鎖アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基で、詳しくは、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、セーブチル、トリデシル、2-メタンスルホニルエチル、3-(3-ペンタデシルフェノキシ)プロピル、3-{4-{2-[4-

(4-ヒドロキシフェニルスルホニル)フェノキシ)ド デカンアミド} フェニル} プロピル、2-エトキシトリ デシル、トリフルオロメチル、シクロペンチル、3-(2,4-ジーt-アミルフェノキシ)プロピル)、ア リール基(例えば、フェニル、4-t-ブチルフェニ ル、2, 4-ジ-t-アミルフェニル、<math>2, 4, 6-ト リメチルフェニル、3ートリデカンアミド-2,4,6 ートリメチルフェニル、4ーテトラデカンアミドフェニ ル)、ヘテロ環基(例えば、2-フリル、2-チエニ ル、2-ピリミジニル、2-ベンゾチアゾリル)、シア ノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、スルホ 基、アミノ基、アルコキシ基(例えば、メトキシ、エト キシ、2-メトキシエトキシ、2-ドデシルエトキシ、 2-メタンスルホニルエトキシ)、アリールオキシ基 (例えば、フェノキシ、2-メチルフェノキシ、4-t ーブチルフェノキシ、3ーニトロフェノキシ、3ーt-ブチルオキシカルバモイルフェノキシ、3-メトキシカ ルバモイル)、アシルアミノ基(例えば、アセトアミ ド、ベンズアミド、テトラデカンアミド、2-(2,4 ージーセーアミルフェノキシ) ブタンアミド、4-(3 - t - ブチル - 4 - ヒドロキシフェノキシ) ブタンアミ ド、2-{4-(4-ヒドロキシフェニルスルホニル) フェノキシ} デカンアミド)、アルキルアミノ基(例え ば、メチルアミノ、ブチルアミノ、ドデシルアミノ、ジ エチルアミノ、メチルブチルアミノ、ビス(2-ヒドロ キシエチル) アミノ)、アニリノ基(例えば、フェニル アミノ、2-クロロアニリノ、2-クロロー5-テトラ デカンアミノアニリノ、2-クロロ-5-ドデシルオキ シカルボニルアニリノ、N-アセチルアニリノ、2-ク ロロー5-{2-(3-t-ブチル-4-ヒドロキシフ ェノキシ) ドデカンアミド アニリノ)、ウレイド基 (例えば、フェニルウレイド、メチルウレイド、N, N -ジブチルウレイド)、スルファモイルアミノ基(例え ば、N, N-ジプロピルスルファモイルアミノ、N-メ チルーNーデシルスルファモイルアミノ)、アルキルチ オ基(例えば、メチルチオ、オクチルチオ、テトラデシ ルチオ、2-フェノキシエチルチオ、3-フェノキシプ ロピルチオ、3-(4-t-ブチルフェノキシ)プロピ ルチオ)、アリールチオ基(例えば、フェニルチオ、2 ーブトキシー5ー tーオクチルフェニルチオ、3ーペン タデシルフェニルチオ、2-カルボキシフェニルチオ、 4-テトラデカンアミドフェニルチオ)、アルコキシカ ルボニルアミノ基(例えば、メトキシカルボニルアミ ノ、テトラデシルオキシカルボニルアミノ)、スルホン アミド基 (例えば、メタンスルホンアミド、ヘキサデカ ンスルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、pートル エンスルホンアミド、オクタデカンスルホンアミド、2 ーメトキシー5ーtーブチルベンゼンスルホンアミ ド)、カルバモイル基 (例えば、N-エチルカルバモイ ル、N, N-ジブチルカルバモイル、N-(2-ドデシ

ルオキシエチル) カルバモイル、N-メチル-N-ドデ シルカルバモイル、N-{3-(2,4-ジーt-アミ ルフェノキシ) プロピル} カルバモイル)、スルファモ イル基 (例えば、N-エチルスルファモイル、N, N-ジプロピルスルファモイル、N-(2-ドデシルオキシ エチル) スルファモイル、N-エチル-N-ドデシルス ルファモイル、N, N-ジエチルスルファモイル)、ス ルホニル基(例えば、メタンスルホニル、オクタンスル ホニル、ベンゼンスルホニル、トルエンスルホニル)、 アルコキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニ ル、ブチルオキシカルボニル、ドデシルオキシカルボニ ル、オクタデシルオキシカルボニル)、ヘテロ環オキシ 基(例えば、1-フェニルテトラゾール-5-オキシ、 2-テトラヒドロピラニルオキシ)、アゾ基(例えば、 フェニルアゾ、4-メトキシフェニルアゾ、4-ピバロ イルアミノフェニルアゾ、2-ヒドロキシ-4-プロパ ノイルフェニルアゾ)、アシルオキシ基(例えば、アセ トキシ)、カルバモイルオキシ基(例えば、N-メチル カルバモイルオキシ、N-フェニルカルバモイルオキ シ)、シリルオキシ基(例えば、トリメチルシリルオキ シ、ジブチルメチルシリルオキシ)、アリールオキシカ ルボニルアミノ基(例えば、フェノキシカルボニルアミ ノ)、イミド基(例えば、N-スクシンイミド、N-フ タルイミド、3-オクタデセニルスクシンイミド)、ヘ テロ環チオ基(例えば、2-ベンゾチアゾリルチオ、 2, 4-ジーフェノキシー1, 3, 5-トリアゾールー 6-チオ、2-ピリジルチオ)、スルフィニル基(例え ば、ドデカンスルフィニル、3-ペンタデシルフェニル スルフィニル、3-フェノキシプロピルスルフィニ ル)、ホスホニル基(例えば、フェノキシホスホニル、 オクチルオキシホスホニル、フェニルホスホニル)、ア リールオキシカルボニル基 (例えば、フェノキシカルボ ニル)、アシル基(例えば、アセチル、3-フェニルプ ロパノイル、ベンゾイル、4ードデシルオキシベンゾイ ル)、シリル基(例えば、トリメチルシリル、トリエチ ルシリル、セーブチルジメチルシリル、トリフェニルシ リル)、アゾリル基(例えば、イミダゾリル、ピラゾリ ル、3-クロローピラゾール-1-イル、トリアゾリ ル)を表わす。

【0049】好ましくはR1 はハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基もしくはジアルキルアミノ基である。

【0050】Ar⁴、Ar⁵、Ar⁶、およびAr⁷は 置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わすが、無置換の場合は、フェニル基、1ーナフチル基又は 2ーナフチル基である。置換のフェニル又はナフチル基 の場合、置換基としては前記Ar¹~Ar³が有する置 換基があげられ、好ましい置換基はアルキル基、アリー ル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ジアルキルア ミノ基、ジアリールアミノ基、N-アルキル-N-アリ

ールアミノ基又はニトロ基である。ニトロ基以外の好ま しい置換基の具体例をあげれば、メチル、エチル、イソ プロピル、nーブチル、tーブチル、もしくはnーオク チルなどのアルキル基、フェニル、ビフェニル、テルフ ェニル、pージメチルアミノフェニル、pージブチルア ミノフェニル、pージフェニルアミノフェニル、1ーナ フチルもしくは2ーナフチルなどのアリール基、メトキ シ、エトキシ、イソプロポキシもしくはベンジルオキシ などのアルコキシ基、フェノキシ、4ービフェニルオキ シ、4-メトキシフェノキシ、4-二トロフェノキシ、 4-ジエチルアミノフェノキシ、1-ナフトキシもしく は2-ナフトキシ基などのアリールオキシ基、ジメチル アミノ、ジエチルアミノ、ビス (2-ヒドロキシエチ ル) アミノ、エチルメチルアミノもしくはジブチルアミ ノなどのジアルキルアミノ基、ジフェニルアミノ、ビス (4-メトキシフェニル) アミノ、ビス (4-ジメチル アミノフェニル) アミノ、N-フェニル-N-ナフチル アミノ、もしくは、N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミンなどのジアリールアミノ基、Nーメチル -N-フェニルアミノ、N-エチル-N-(3-メチル フェニル) アミノ、N-メチル-N-(1-ナフチル) アミノもしくはNーブチルーNー(4-t-ブチルフェ ニル) アミノなどのN-アルキル-N-アリールアミノ 基である。特に好ましい置換基はアルキル基、アリール 基、ジアルキルアミノ基又はニトロ基である。尚、Ar ⁴ とAr⁵、Ar⁶ とAr⁷ は互いに結合して環を形成 してもよい。

【0051】R² はハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基又はジアルキルアミノ基を表わすが、詳しくは、フッ素、塩素もしくは臭素などのハロゲン原子、メチル、エチル、イソプロピル、もしくはtーブチルなどのアルキル基、メトキシ、エトキシ、ブトキシもしくはイソプロポキシなどのアルコキシ基、又は、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、エチルメチルアミノもしくはジブチルアミノなどのジアルキルアミノ基を表わす。好ましくはフッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基又はジメチルアミノ基である。

【0052】 Ar^8 、 Ar^9 、 Ar^{10} 、 Ar^{11} 、 Ar^{12} および Ar^{13} は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わすが、詳しくは前記 Ar^4 $\sim Ar^7$ と同義の基を表わす。尚 Ar^8 と Ar^9 、 Ar^{10} と Ar^{11} および Ar^{12} と Ar^{13} は互いに結合して環を形成してもよい。

【0053】 Ar^{14} 、 Ar^{15} 、 Ar^{16} 、 Ar^{17} 、 Ar^{18} および Ar^{19} は置換もしくは無置換のフェニル又はナフチル基を表わすが詳しくは前記 Ar^4 $\sim Ar^7$ と同義の基を表わす。尚、 Ar^{14} と Ar^{15} 、 Ar^{16} と Ar^{17} 、および Ar^{18} と Ar^{19} は互いに結合して環を形成してもよい。

 $[0054]R^3$, R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R

9 およびR10は置換もしくは無置換のアルキル基を表わ すが、詳しくは炭素数1~20の直鎖もしくは分岐鎖の アルキル基であり、無置換のアルキル基の具体例をあげ れば、メチル、エチル、ローブチル、イソプロピル、イ ソブチル、セーブチル、nーペンチル、シクロペンチ ル、n-ヘキシル、シクロヘキシル、n-オクチル、n ードデシル、2-エチルヘキシル、エチレン、トリメチ レン、テトラメチレン又はペンタメチレンなどの1価又 は2価のアルキル基である。 置換アルキル基はこれら無 置換のアルキル基に、前記R1 で定義した基が置換した ものであるが、好ましい置換基はハロゲン原子、ヒドロ キシ基、シアノ基、アルコキシカルバニル基、アルコキ シ基、もしくはジアルキルアミノ基である。好ましい置 換アルキル基の具体例をあげれば2-クロロエチル、2 ーヒドロキシエチル、2ーシアノエチル、2ーエトキシ カルボニルエチル、ベンジル、2-ジメチルアミノエチ ル、2-メトキシエチル、2-(2-メトキシエトキ シ)エチル、-CH₂ CH₂ OCH₂ CH₂ -又は、- CH_2 CH_2 $N-(CH_3)CH_2$ CH_2 -などである。 【0055】R3~R10は特に好ましくは炭素数1~6 の無置換のアルキル基である。

【0056】R11およびR14は水素原子又は低級アルキ ル基を表わすが、低級アルキル基を詳しく説明すればC ₁~C₆のアルキル基であり、例えばメチル、エチル、 n-ブチル又はt-ブチル基である。R12およびR13は 水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェ ニル基、低級ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換 のジフェニルアミノ基、低級アルコキシ基又はニトロ基 を表わすが、水素原子とニトロ基以外について詳しく説 明すれば、メチル、エチル、n-ブチル、t-ブチルも しくはn-ヘキシルなどの低級アルキル基、フェニル、 o-、m-もしくはp-メチルフェニル、p-フェニル フェニル(pービフェニルイル)、pージエチルアミノ フェニルもしくはpーメトキシフェニルなどの置換もし くは無置換フェニル基、ジメチルアミノ、ジエチルアミ ノもしくはジn-ブチルアミノなどの低級ジアルキルア ミノ基、ジフェニルアミノ、N-(3-もしくは4-メ チルフェニル) -N-フェニルアミノ、ビス (4-ジエ チルアミノフェニル) アミノ、もしくはビス (4-メト キシフェニル) アミノなどの置換もしくは無置換のジフ ェニルアミノ基、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ 低級アルコキシ基である。

【0057】好ましくは、R¹¹およびR¹⁴は水素原子又はメチル基であり、R¹²およびR¹³は水素原子、低級アルキル基、低級ジアルキルアミノ基、低級アルコキシ基もしくはニトロ基である。特に好ましくはR¹¹およびR¹⁴は水素原子であり、R¹²およびR¹³は低級ジアルキルアミノ基である。

【0058】R15およびR18は水素原子又は低級アルキ

ル基、R¹⁶およびR¹⁷は水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、低級アルコキシ基、低級ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基又はニトロ基を表わし、R¹⁵~R¹⁸がすべて同時に水素原子であることはない。又、R¹⁶とR¹⁷が同時に低級アルキル基であることはない。各置換基の詳しい説明はR¹¹~R¹⁴の場合と同じである。

【0059】好ましくはR15およびR18は水素原子又は メチル基であり、R16およびR17は水素原子、低級ジア ルキルアミノ基、低級アルコキシ基もしくはニトロ基で ある。特に好ましくはR15およびR18は水素原子であ り、R16およびR17は低級ジアルキルアミノ基である。 【0060】次に一般式(I)~(VII)において数を表 わす 1、m、n、p、g、rおよびsについて説明す る。1は0ないし4の整数を表わすが、好ましくは0か ら2であり、特に好ましくは0である。mは1ないし6 の整数を表わすが、好ましくは1ないし3であり、特に 好ましくは1又は2である。nは2以上の整数を表わす が、好ましくは2ないし6であり、特に好ましくは2な いし4である。pは0ないし4の整数を表わすが、好ま しくは0ないし2であり、特に好ましくは0又は1であ る。qは1以上の整数を表わすが、好ましくは1ないし 4であり、特に好ましくは1又は2である。rは2以上 の整数を表わすが、好ましくは2ないし5であり、特に 好ましくは2又は3である。sは2ないし4の整数を表 わすが、好ましくは2又は3であり、特に好ましくは2 である。

【0061】次にパラジウム、触媒について説明する。本反応における触媒活性種は0価のパラジウム錯体であるが、還元力のある有機金属試薬を用いるクロスカップリング反応では2価のパラジウム錯体を用いても、反応系中で自動的に0価に還元される。また、2価の錯体に触媒量の還元剤を加えたり、配位子として過剰の第三級ホスフィンを加えたりしても、系内で0価に還元され、触媒として機能する。一般にPd(O)錯体は空気中であまり安定なので、系内で還元する方法がよく用いられる。

【0062】好ましいパラジウム触媒としては、0価を用いる場合、Pd (PPh $_3$) $_4$ 又は、Pd $_2$ (dpa) $_3$ (dpa=ジベンザルアセトン)であり、2価を用いる場合、Pd (OCOCH $_3$) $_2$ 、(C $_3$ H $_5$) $_2$ Pd $_2$ C1 $_2$ 又はPdC1 $_2$ (PPh $_3$) $_2$ であり、これらはしばしばPPh $_3$ などの第三級ホスフィンや、dppe(1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン)、dpf(1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン)などの二座配位子ビスホスフィンの共存下で用いられる。

【0063】次に本発明の方法により合成される「分子内に少なくとも2つの芳香族三級アミンを有し、かつ、少なくとも1つの芳香族炭化水素環系環集合基を有する化合物」の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。。

【0064】 【化22】

$$(C_2H_5)_2N \longrightarrow N(C_2H_5)_2$$

[0065]

【化23】

(5)
$$(C_2H_5)_2N$$
 $N(C_2H_5)_2$ $N(C_2H_5)_2$ $N(C_2H_5)_2$

$$(9) (n-C_4H_8)_2N \longrightarrow N(C_2H_5)_2$$

$$(n-C_4H_8)_2N \longrightarrow N(C_2H_5)_2$$

$$(10.66)$$

[0066]

(10)
$$CH_3 \longrightarrow N \longrightarrow N \times (n-C_4H_9)_2$$

$$OCH_3 \longrightarrow N \times (n-C_4H_9)_2$$

[0067]

【化25】

(16)

(17)

CH₃

[0068] [化26]

(19)

(20)

[0069]

【化27】

[0070]

(26)
$$C_2H_5$$
 C_2H_5 $C_2H_$

$$\begin{array}{c}
0_2N & & & \\
0_2N & & & & \\
0_2N & & & & \\
\end{array}$$

【0071】次に本発明の一般式(I)~(X)で表わされる 化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定される ものではない.

[0072]

【表1】

表 1

	表1						
	Ar¹	Ar²	Χ¹	X¹の 結合位	R¹	1	R¹の 結合位
I-1	<u></u>	\bigcirc	I	4	_	0	
I-2	CH ₃	\bigcirc	I	4	_	0	_
1-3			I	4		0	-
I-4	C ₂ H ₅ N-	\bigcirc	I	4	_	0	
I-5	C ₂ H ₅ N - C	C ₂ H ₅ N	I	4	_	0	_
I-6	n-C ₄ H ₉ N-	Me0-{	I	4	_	0	_
1-7	MeO-()	Me0-(C)-	I	4		0	_
1-8	© N-⊙-	© N-⊙	[4	_	0	-
1-9	NO 2	NO 2 -	Br	4	-	0	_
I-10	⊘ √ ○ ≻		Br	3	CH3	1	4

[0073]

表2(表1の続き)

	Ar ^t	Ar²	Χ¹	I'の 結合	R'	1	R¹の 結合 位
	AT	A 1		位		Ŀ	莅
I-11		\bigcirc	Cl	4	Cl	2	2,6
I-12			-050 ₂ CF ₃	4	I	ı	3
I-13			I	2	I	1	4
I-14	\bigcirc \leftarrow \bigcirc	$\bigcirc\!$	1	4	CH₂0-	1	2
I-15	CH ₉ N-O	\Diamond	Cl	4	CH ³ N-	1	2
[-16	MeOCH2CH2N	MeOCH ₂ CH ₂ N * MeOCH ₂ CH ₂ CH ₂	-0SO₂CH₃	4	_	0	_
1-17		t-C4He	-0S0 ₂ -	4	Br	1	3
1-18		\bigcirc	Ī	4	P	ı	2
1-19	0		1	4	<u> </u>	0	_
1-20	. 0			4	_	0	_

【0074】 【表3】

(Ar³) (X²)_m 一般式 (II)

表3

	42.0		
	Ar³	Χ²	m
11-1		— B (OH) 2	1
11-2	£ - 0 0	— B (OH) z	1
11-3		— B (OH) ₃	. 1
11-4	C ₂ H ₅ N - C	~B(CH)₂	1
11 5	Me0	— B (GH) ₂	1
11-6	0 ₂ N - ()-	— B (OH) ₂	1

[0075]

【表4】

表4(表3の続き)

	表4(表3の続き)		·
	Ar³	X²	m
11-7		B (OH) ₂	1
11 – 8		— B (OH) ₂	2
11 – 9	♦	— B (OH) ₂	2
11-10		B (OH) ₂	3
11-11		— B (ОН) ₂	2
11-12	◆◆◆	— MgBr	2
11-13		- ZnC1	2

[0076]

表5(表3の続き)

	Ar ^s	X²	m
11-14		— Si (CH*) 3	3
11-15		-B(OCH ₂) ₂	3
11 – 16	n	—Cu	1
11-17	C2Hs N N N N C2Hs N C2Hs N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	— B (CH) ₂	1
11-18	MeO N-O-	-f(0)	. 1
II — 19	(n-C ₄ H ₉) ₂ N N N	— Sn (n-Bu) 3	1
11-20		−B(n−Bu);	1

[0077]

表6(表3の続き)

	Ar³	X²	m
11-21	\bigcirc	-A1(i~Bu)z	1
11-22	100	— B (OH) ₂	6
11-23	c1-{(()}-	— B (OH) ₂	1
[[-24		SiCH₃Cl₂	1
11-25		—S1(C2H5)3	1
11-26		— B (OH) _E	1

【0078】 【表7】.

-	$ \begin{array}{c} Ar^1 \\ Ar^2 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} $	一般式(III)
act (

	改(
	Ar¹	. A r 2	X²	X2の 結合	Rι	1	R'の 結合 位
 -1	\bigcirc	\Diamond	-B (OH) 2	4	_	0	_
 -2	CH ₃	\Diamond	-В (ОН) ₂	4	ı	0	_
III - 3		\Diamond	-B (OH) z	4	1	0	1
[[[- 4	C ₂ H ₅ N-	\bigcirc	B(OH) ₂	4	ı	0	
111 - 5	C ₂ H ₅ N-	C ₂ H ₅ N-()	B(OH) ₂	4	-	0	_
111 - 6	n-C ₄ H ₀ N	NeO-()-	B (OH) 2	4	ı	0	_
111 - 7	MeO-()	NeO-()	B(OH) ₂	4	1	0	
111 - 8	ON-O	O N-O	В (ОН) г	4	ı	0	1
III - 9	NO ₂ -	NO.	B(OH) ₂	4	_	0	_
- 10	⊘ ◆	(H,	MgBr	3	CH ₃	1	5

[0079] [表8]

表8(表7の続き)

	Ar¹	. Ar²	X2	なるのは	R¹	ı	R'の 結合 位
III -11	\bigcirc	⊘ ◆	-ZnC i	4	СН	1	2
		000	-Si(CH ₃);	4	1	0	_
III -13			-B(OCH ₂) ₂	3		0	_
111 -14		\bigcirc	Си	4	Cl	2	2
111 -15	CB 3 N-O	CH,	-6	4	-OCH ₃	l	2
111 -16		MeON	-Sn (n-Bu) s	4	_	0	_
		t-C4H3-	-B(n-Bu) ₂	4.	_	0	_
III -18		OCH ³	Al(i-Bu) ₂	3	сн _э >и-	1	5
[] [] -19	CH ₃	\bigcirc	-SiC ₂ H ₅ Cl ₂	4	_	0	_
111 -20		<u> </u>	-8 (OH) 3	4	_	0	_

[0080]

(Ar³) (X¹)_m 一般式 (IV)

	表 9		
	Ar³	Χ¹	m .
[V 1		1	1
IV- 2	CH ₃	ľ	1
[V – 3		I	. 1
IV- 4	C ₂ H ₅ N — C	I	1
IV- 5	Me0	I	1
IV- 6	0 ₂ N	8r	1
IV- 7	©-(©)-(©)-(©)-(©)-(©)-(©)-(©)-(©)-(©)-(©	I	1
0		•	

[0081]

【来1 ∩ `

表10(表9の続き)

	Ar³	X'	m
11 - 9	- ◇-◇-	Ī	2
IV-10		t	3
IV-11	Q	I	4
IV-12	\$	ī	6
[V-13		- OSO _z CF ₃	2
IV-14		I	2 .
11-15		Br	2

【0082】 【表11】

表11(表9の続き)

	Ar ³	X 1	m
17-16		1	3
IV-16		1	3
IV-17	C ₂ H ₆	1	2
IV-18	r\	Br	1
IV — 19	C ₂ H ₅ N N N N C ₂ H ₅ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1	1
IV-20	MeO N-O-	1	1
IV-21	n-C4He0 N-C-	·1	1

【表12】

[0083]

表12 (表9の続き)

	Ar³	X¹	m
1V-21		CI	L
IV22	©-©>	-0\$0 _z -	Į
IV-23		-0S0 ₂ CF ₂	6
IV-24	¢1-⟨◯⟩-	Ī	1
IV-25		OSO _z CH _z	1
IV-26		I	1
	© _N -	1	1

[0084]

表13

	2013							
	Ar ⁴	Ar*	Ar ⁸	Ar ⁷	R²	n	р	R²の結合位
V - 1	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	-	2	0	
V – 2	(C)	CH ₃	\Diamond	(्रेंड	ı	2	0	_
V - 3	\bigcirc		\bigcirc		_	2	0	
V - 4	\bigcirc	CH ₃	\bigcirc	CH ₃	_	3	0	_
V – 5	○	CH ₃	\bigcirc	Cits		4	0	_

表14 (表13の続き)

	Ar ⁴	Ar ⁵	Ar ⁸	Αr ^τ	R²	n	р	R [®] の結合位
V 6	\bigcirc	\bigcirc	\Diamond	\Diamond	СН₃	2	2	共にアミノ基 のメタ位
V - 7	C ₂ H ₅ N-	\bigcirc	C ₂ H ₅ N-	\bigcirc	-	2	0	_
V - 7	C2115 N-()-	C2118 N-()-	C2115 C2116 N-	C ₂ H ₅ N-	_	2	0	_
V – 8	C2H3 N-	MeO-{>	Calla N-	MeO-{O}-	_	2	0	
v – 9	MeO-()-	MeO-{O}-	McO-{	McO-{\rightarrow}-		2	0	_

[0086]

【表15】

表15(表13の続き)

	Ar ⁴	Ar ⁵	Ar*	Αг	R*	n	p	R ² の結合位
V-10	C ₂ H ₅ N-	C ₂ H ₄ N-()	n-C4H9 N-()-	n-C4H4 N-	ı	2	0	_
v-11	0	Cla		0	1	2	0	_
V – 12	CH ₃ N-C	CH ³ >N-{O}-	CH ₃ N-	CH ₃ N-	_	3	0	****
V-13	CH ₃ N-(O)-	CH ³ N-(O)-	C ₂ H ₅ N-	C ₂ H ₅ N-	ı	4	0	-
V-14	t-C4Hp-	\Diamond	i -C3117 -	\bigcirc	1	6	0	_

[0087]

表 16 (表 13の続き)

【表16】

	3X 1 0 (3X 1 0 c	24%C7						
	Ar ⁴	Ar ⁵	Αr ⁶	Αr¹	R*	n	р	R'の結合位
V-15	02N-	0,N-(C)-	02N-()	02N-()-	_	3	0	_
V-16					_	2	0	1
V-17		1			CH#0-	2	2	アミノ基の オルト位
V-18					_	3	0	_
V - 19	Q [']	\	0			4	0	-

[8800]

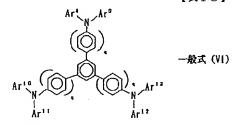
【表17】

表17(表13	}の続き)
---------	-------

	Ar ⁴	Ar ⁵	. Ar	Ar ⁷	R*	n	р	R*の結合位
V-20	0) ()	⊘	CH,	_	2	0	-

[0089]

【表18】



发18

	Ar*	Ar	A r 10	A r 11	A r 12	A r 13	q
- I	<u></u>	○	\bigcirc	⊘	<u></u>	<u></u>	1
V(- 2	○	CH ₃	\bigcirc	CH.	<u></u>	CH ₃	1
VI - 3	○ ·	CH ₃	\bigcirc	CH ₃	©	CH ₃	2
VI 4	C ₂ H ₅ N (○ .	C ₂ ₃ N-	⊘	C ₂ H ₅ N-	<u></u>	1
VI - 5	C_2H_3 N $-$	C2H3 N-O-	C ₂ H ₅ N-	C ₂ H ₅ N	C ₂ H ₅ N	C2H5 N-()	1

[0090]

【表19】

TOY N(C, 115)2 Med-A r 13 Me0 🔷 (Calls) 2N Neo O A r 13 \bigcirc (C2H5)1N (C2H5)1 A r' Weo O A r 10 \bigcirc N(C₂H₈), Med-{ 表19 (表18の続き) CH₃ N CH₃ Med 🔷 Ar (I VI - 10

【0091】 【表20】

表20

	A r 14	A r 15	A r 18	Ат11	A r 11	A r 19	r
VI I - 1	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	⊘ -	○	<u></u>	2
VI I -2	CH ₃	\Diamond	CH ₃	<u></u>	CH ₃	<u></u>	2
-3	· 🕞		\Diamond		⊘ -		2
VI I -4	0 a N - (C)	0 z N - ()-	0 z N - (O)-	0zN-()-	02N-()-	0 ₁ N-{○}-	3
VII -5	CH ₃ N-O	CH3 N-	CH 3 N - CO-	CH3 N-	CH ₃ N-C	CH ³ N-O	2

[0092]

【表21】

表21 (表20の続き)

_							
	A r 14	A r 15	A r 10	Aru	A r **	A r 11	r
VI I -6	MeO-(Me0-(HeO-()	MeO-()	MeO-()-	MeO-(O)-	4
VII -7	CII.	Me0-(CH ₃ N-()	Me0-(CH3 N-O-	MeO-(O)-	6
-8		\bigcirc \bigcirc	\bigcirc		\bigcirc \bigcirc	\bigcirc	2
711 -9	CH ₃	CH.,	CH ³	© CH₃	(H ₃)	F5 (O)	5
VII -10	MeO O	OMe	MeD O	DMe DMe	MeO O	OM/e	2

[0093]

【表22】

	s	83	2	E.	4	8
	R 10	*HD	чн гэ	n-C,Hp	CH30CH2CH2- CH30CH2CH4- CH30CH2CH4- CH30CH4CH2- CH30CH3CH3- CH30CH3CH3- CH30CH3CH3- CH30CH3CH3-	-(cll ₂) _T -
	R	CH3	9H2)	C _t H ₆	-*HЭ*HЭ0¢НЭ	3)-
—後式 (VIII)	Rª	CH3	C2Hs	n-C,Ho	CH30CH2CH3-	۲.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	R7	CH3	C2Hs	C.H.	CH30CH2CH2-	-(CH ₂)-
\$; ©Ø	R	GII:	C ₂ Hs	n-C4II.	CH 4 OCH 4 CH 2-	7:
	R	*II)	Calls	C, Hs	CH3OCH2CH2-	-(CH2)T
R R R R	R4	CH.	Cells	n-C.H.	CH30CH2CH3-	k
22 23 24 25	R	CII	C ₂ lls	C2Hs	CH3OCH2CH2-	-(CII1)-
		VIII - 1	VIII -2	VIII -3	VIII - 4	8 – 1114

[0094]

【表23】

表23(表22の続き)

	14 - U (34)	2 2 47 40 (1)							
	R¹	R¹	R ⁵	Rª	R'	R*	R°	RIO	s
- 6	-(CH ₂) ₁ -0-(CH ₂) ₂		-(CH ₂) ₂ 0 -(CH ₂) ₂		-(CH ₂) = 0 -(CH ₂) =		-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -		2
VIII - 7	NCCH2CH2 —	NCCH2CH2—	NCCH2CH2 —	NCCH2CH2 —	NCCH2CH2—	NCCH2 CH2 -	NCCH2 CH2 —	NCCH2CH2-	2
- 8	\triangleright	\triangle	\triangle	\rightarrow	\triangleright	\triangleright	\triangleright	>	2

[0095]

【表24】

	R¹¹	R12	R13	R14
1X-1	H	H	H	Н
11 - 2	CH3	Н	н	Н
1X-3	н	CaHs N-	C ₂ H ₅ N -	Н
11 4	H	CH3O—	CH ₂ O—	Н
IX— 5	Н .	N-	CH.	Н
1X 6	H	C ₂ H ₅ N —	CH2O−	Н
1X-7	Н	-NO:	-NO ₂	Н
11 - 8	X-8 H CH3 N-		CH ₃ N-	Н

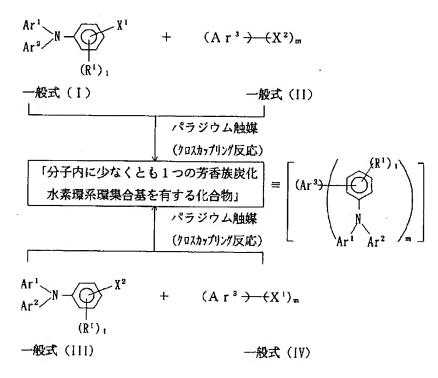
【0096】 【表25】

	R 15	R 18	R17	R18
X - 1	CH₃	Н	Н	Н
X - 2	Н	CH ₃	СН₃	Н
X – 3	Н	C ₂ H ₅ N-	C ₂ H ₅ N-	Н
X - 4	Н	CH3O-	CH3O-	Н
X – 5	Н	CH ₃	CH₃ N —	н
X - 6	Н	C ₂ H ₅ N -	СН₃О —	Н
X – 7	Н	NO ₂	-NO ₂	Н
x – 8	Н	CH ₃ N-	CH ₃ N -	Н

【0097】本発明の製造方法をスキームで示すと下記 (スキーム1)のようになる。

【0098】 【化29】





式中、Ar¹、Ar²、Ar³、X¹、X²、R¹、lおよび mは前記と同義である。

【0099】一般式(I)および(IV) の特に好ましいX¹ はヨウ素原子であるが、その合成は日本化学会編「新実験化学講座」第14巻-I、418頁、1977年、丸善(株)、日本化学会編「第4版有機化学講座」第19巻、460頁、1992年、丸善(株)、および、E.B. Merkushev,Synthesis,1988,925などに記載の方法により行なうことができる。

【0100】一般式(II)および(III)で表わされる芳香族基にマグネシウム、亜鉛、銅、ホウ素、アルミニウム、ケイ素又はスズ元素由来の基が結合した化合物の合成は、近年多くの報告がなされているが、マグネシウム化合物については日本化学会編「新有機化学講座」第24巻(有機合成VI)、丸善、1992年の39~52頁に、ホウ素化合物については同書、60~90頁に、アルミニウム化合物については同書90~106頁に、ケイ素化合物については同書121~169頁に、スズ化合物については同書179~199頁に詳しく合成法が記載されている。

【0101】亜鉛化合物の合成法については日本化学会 編「新実験化学講座」第12巻、1976年、丸善

(株)の272~274頁、より具体的には、Org.Synt h,66,67(1987) に詳しく記載されている。銅化合物の合成法については同書、264~267頁に詳しく記載さ

れている。

【0102】本反応はパラジウム触媒により行なわれるが、用いられる錯体触媒を具体的にあげるとPd (PP h_3) $_4$ 、Pd $_2$ (dpa) $_3$ 、Pd (OCOC H_3) $_2$ 、(C $_3$ H $_5$) $_2$ Pd $_2$ Cl $_2$ 又はPdCl $_2$ (PP h_3) $_2$ などである。用いられる量は基質に対して、0.00001~10モル%であり、好ましくは0.0001~1 モル%である。

【0103】触媒量のトリフェニルホスフィン、1,2ービス(ジフェニルホスフィノ)エタン(dppe)、又は1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン(dppf)などの第三級ホスフィンを共存させて行なうと収率が向上する場合が多いが、添加量は通常触媒の量に対して同モル量以上であり、好ましくはモル量にして15~100倍であり特に好ましくは10~50倍量である。

【0104】スズ化合物を用いる場合LiClを加えると収率向上に効果がある場合があるが、その場合大過剰に用いるのが好ましい。用いる量は基質に対して約3~50当量であり、好ましくは5~15当量である。

【0105】ホウ素化合物を用いる場合、通常塩基の存在下にて反応を行なうが、用いられる塩基はトリエチルアミンもしくはピリジンなどの有機塩基、炭酸カリウ

ム、もしくは炭酸ナトリウムなどの無機塩基である。どちらの塩基を用いるかは溶媒によって決められるが、一般に無機塩基は水共存下で行なう場合に用いられる。用いられる量は基質に対して同モル量以上であり、通常1~5モル当量であり、好ましくは2~3モル当量である。

【0106】ケイ素化合物を用いる時はフッ化リチウム、フッ化セシウム、フッ化テトラブチルアンモニウムもしくはトリス(ジエチルアミノ)スルホニウムジフルオロトリメチルシリカートなどのフッ化物イオン源や、水酸化ナトリウムなどの水酸イオン源を加えて行なわれる。用いられる量は基質に対しての同モル以上であり好ましくは1~3モル当量である。

【0107】反応溶媒としてはnーへキサンなどの脂肪 族炭化水素系、トルエンなどの芳香族炭化水素系、酢酸 エチルなどのエステル系、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドもしくはヘキサメチルホスホルアミド などのアミド系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1、3ージオキソラン、1、1ージエチルメタンもしくはジオキサンなどのエーテル系、ジクロロメタンもしくはクロロホルムなどのハロゲン系、メタノールもしくはイソプロパノールなどのアルコール系または水が用いられるが、これらの混合溶媒もしばしば用いられる。どの溶媒系を用いるかは、反応に用いる金属錯体基質の種類により適宜決められるが、好ましくは芳香族炭化水素系、アミド系、エーテル系又は水一芳香族炭化水素系溶媒の2相系溶媒である。用いる溶媒の量は基質を溶かしうる量であり特に制限はない。

【0108】反応温度は、-78C \sim 200 $^{\circ}$ Cであり、好ましくは-20C \sim 150Cであり、特に好ましくは50C \sim 120Cである。反応時間は一概に決められないが、通常、1時間 \sim 12時間で反応は終結する場合が多い。

【0109】本発明の方法により得られる本発明の合成中間体および芳香族三級アミン化合物の単離精製は、その性質によりカラムクロマトグラフィー法、晶析法もしくは抽出法のいずれか又はそれらの併用により行なわれる。

[0110]

【実施例】次に実施例に基づき、本発明の合成方法を詳 しく説明する。

実施例1(例示化合物X-1の合成)

4-メチルジフェニルアミン21.9g(0.1mole) (アルドリッチ社より購入)と4-ヨードニトロベンゼン32.4g(0.13mole)をジメチルホルムアミド500mlに溶かし、その中に銅粉を12.7g(0.2mole)と炭酸カルシウム20.7g(0.15mole)を入れ、100℃で約24時間加熱攪拌した。反応液を水に注ぎ、クロロホルムにて3回抽出し、後処理後濃縮し、残査をカラムクロマトグラフィにて精製すると、4 -メチル-4' -ニトロトリフェニルアミンを25.9 g (収率85%) 得ることができた。

【0111】得られた4-メチル-4′-ニトロトリフ ェニルアミン20.0g(0.066mole)を常法によ り中性鉄還元することにより4-アミノ-4′-メチル トリフェニルアミン17.2g(収率95%)を得た。 【0112】4-アミノ-4′-メチルトリフェニルア ミン15g (0.055mole)、氷50g、水60mlお よび濃硫酸57ml(0.68mol)をフラスコに入れ、 メカニカルスターラーで攪拌した。その中に亜硝酸ナト リウム4.1g(0.060mol)を水55mlに溶かし 内温が5℃以上にならない程度の速度で滴下した。滴下 終了後約1時間同温で撹拌し、得られたジアゾニウム塩 水溶液に、5℃以下でヨウ化カリウム13.5g(0. 082mol)の70ml水溶液を30分間で滴下した。滴 下後1時間同温で撹拌し、室温に戻して2時間撹拌後反 応溶液を酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥(無水硫酸マ グネシウム)、溶媒減圧留去した。得られた結晶性化合 物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、 例示化合物 (X-1)を20.5g (収率73%) 得

【0113】実施例2,3および4(例示化合物(X-3)、(X-4)および(X-8)の合成) ビス(4-ジエチルアミノフェニル)アミン(米国特許3,202,630号記載の方法により合成)、ビス(4-メトキシフェニル)アミン(東京化成より購入)、およびビス(4-ジメチルアミノフェニル)アミン(同仁より購入)を出発原料に用いて実施例1と同様にして例示化合物(X-3)、(X-4)および(X-8)を合成することができた。出発原料からの全収率はそれぞれ67%、70%および68%であった。

【0114】実施例5(例示化合物(X-6)の合成)4-(ジエチルアミノ)アニリン25g(0.152mol)を酢酸エチル100mlに溶かし、その中に水200mlと炭酸水素ナトリウム26g(0.31mol)を加え攪拌した。その中に水冷下塩化アセチル14.1ml(0.20mol)を滴下し、滴下後約1時間攪拌しクロロホルムを加え、抽出操作と通常の後処理を行なった。硫酸マグネシウムで乾燥後ろ過し、濃縮した。得られた結晶性残渣を酢酸エチル/nーへキサン/アセトニトリルの溶媒系で再結晶することにより、4-(ジエチルアミノ)アセトアニリドを35g(定量的)を得た。

【0115】4-(ジェチルアミノ) アセトアニリド10g(49 mool) とp-3-ドアニソール20.4g(87 mool) と銅粉0.62g(9.7 mool)、炭酸カリウム10.0g(72 moole) を三口フラスコに入れ、その中にデカリン20 mlを入れ、メカニカルスターラーで攪拌しながらおよそ180 C (外温) に約 $80 \text{ 時間加熱した。クロロホルムで抽出した後、反応物をシリカゲルクロマトグラフィで精製することにより<math>N-(4 \text{ moole})$

ージエチルアミノフェニル) -N-(4-メトキシフェ ニル) アセトアミド10.6g(収率70%)を得た。 【0116】N-(4-ジエチルアミノフェニル)-N -(4-x)+2mmol)を2-メトキシエタノール50mlに溶かし、その 中に水10mlと水酸化カリウム9.0g(160mmol) を入れ100℃に加熱し、脱アセチル化した。中和後酢 酸エチル抽出し、乾燥、濃縮後残渣にジメチルホルムア ミド50mlと銅粉2.0g(31mmole)と炭酸カリウ ム4. 4g (32 mole) および4-ヨードニトロベン ゼン16.3g(66mmol)を入れ100℃で約24時 間攪拌した。反応液に水を注ぎクロロホルム抽出し、濃 縮後カラムクロマトグラフィにて精製することにより、 4-(ジエトキシアミノフェニル)-4'-メトキシー 4"-ニトロトリフェニルアミンを10.0g(収率8 0%) 得た。

【0117】4-(ジエトキシアミノフェニル)-4′-メトキシー4″-ニトロトリフェニルアミン10g(25.5mol)のニトロ基の還元アミノ化、ジアゾ化、ひきつづくヨード化は実施例1と同様にして行ない例示化合物(X-6)を7.8g(収率65%)得ることができた。

【0118】実施例6(例示化合物(IX-2)の合成) 実施例1で得た例示化合物(IX-1)20g(52mol)をテトラヒドロフラン(THF)200mlに溶かし-78℃に冷却した。その中にn-ブチルリチウムの1.6Mへキサン溶液32ml(52mmol)を滴下した。滴下後30分間攪拌し、その後、ホウ酸トリメチル5.4g(52mmol)のTHF溶液を約1時間で滴下する。1時間攪拌後ゆっくり室温まで温度を上げ、さらに2時間反応させた。次に希硫酸(硫酸12ml+水240ml)を0℃で加え加水分解した。酢酸エチル抽出し、減圧濃縮して得られたボロン酸の固体をトルエン再結により精製すると例示化合物(IX-2)を14.2g(収率90%)得ることができた。

【0119】実施例7~11(例示化合物(IX-3)(IX-4)(IX-6)、および(IX-8)の合成) 実施例2~5で合成した例示化合物(IX-3)(IX-4)(IX-6)および(IX-8)のヨウ化物を用いて実施例6と同様にして、ボロン酸である例示化合物(IX-3)(IX-4)(IX-6)および(IX-8)をそれぞれ88、86、85および、87%の収率で得ることができた。

【0120】実施例12(例示化合物(IX-7)の合成)

4-ヨードニトロベンゼン62.3g(0.25mole) と4-ブロモアニリン17.2g(0.1mole)をジメ チルホルムアミド300mlに溶かしその中に銅粉4g (0.063mole)と炭酸カリウム13.8g(0.1 mole)を入れ、約100℃で24時間攪拌した。水を加 え酢酸エチル抽出し、後処理後減圧濃縮して、得られた 結晶性残渣をカリウムクロマトグラフィーで精製することにより、4-ブロモ-4′,4″-ジニトロトリフェ ニルアミンを31.1g(収率75%)得た。

【0121】4-ブロモー4′, 4″-ジニトロトリフェニルアミン8.3g(0.02mol)から、通常のグリニャール試薬合成法によりマグネシウム金属を用いて、4-〔ビス(4-ニトロフェニル)アミノ〕フェニルマグネシウムブロミドのTHF溶液を調製し、-78℃に冷却後、激しく攪拌しながらホウ酸トリメチル2.1g(0.02mole)のTHF溶液を約1時間で滴下した。その後、実施例6と同様の処理を行ない、例示化合物(IX-7)のボロン酸を6.1g(収率80%)得ることができた。

【0122】実施例13(例示化合物(1)の合成)例示化合物(IX-2)のボロン酸30.3g(0.1mole)、例示化合物(X-1)のヨード化物38.5g(0.1mole)、酢酸パラジウム0.22g(1.0mol)、トリーロートリルホスフィン0.76g(2.5mol)、トリエチルアミン20.2g(0.2mol)およびN,Nージメチルホルムアミド300mlの混合物を100℃で約2時間加熱した。溶媒を減圧留去し、残渣にクロロホルムと10%アンモニア水溶液を加えた。その後抽出操作を行ない、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過・減圧濃縮した。得られた残渣をTHFーエタノール系溶媒で再結晶することにより例示化合物(1)を38.8g(収率75%)得た。

【0123】実施例14~16(例示化合物(5)、(6)および(7)の合成)

例示化合物 (IX-3) と (X-3)、例示化合物 (IX-6) と (X-6) および例示化合物 (IX-4) と (X-4) の組み合わせで実施例13と同様の反応を行ない、同様の後処理により例示化合物 (5)、(6) および (7) を各々収率78、75、および80%で得ることができた。

【0124】実施例17(例示化合物 (11)の合成)例示化合物 (IX-2)のボロン酸69.7g (0.23 mol)と1.4-ジョードベンゼン33.0g (0.1 mol)とPdC 1_2 (PPh_3) $_2$ 0.7g (0.001 mol)、トリエチルアミン50.6g (0.5 mol)トリフェニルホスフィン0.79g (0.003 mol)およびテトラヒドロフラン (THF)の混合物を加熱還流を約2時間行なった。その後実施例13と同様の後処理を行ない例示化合物 (11)を47.4g (収率80%)得ることができた。

【0125】実施例18(例示化合物(12)の合成) 実施例17の1,4ージョードベンゼンの代りに、4, 4'ージョードビフェニルを当モル量用いることにより 例示化合物(12)を収率82%で得ることができた。 【0126】実施例19(例示化合物(15)の合成)

9, 10-ジブロモアントラセン33.6g(0.1mo 1)をエーテル500回に溶かし、-78℃に冷却し た。その中に注射器で1.6M. tーブチルリチウムへ キサン溶液125ml(0.2mol)をゆっくり滴下し た。滴下後徐々に室温まで昇温し、約1時間攪拌後、ア スピレーター減圧下、揮発性溶媒の大部分を留去した。 この濃縮液にTHF500mlを加え、得られた溶液を塩 化亜鉛27.3g(0.2mol)とTHF100mlの溶 液に窒素加圧法によりカニューラを用いて加えた。1時 間攪拌後この溶液にPd (PPh₃)₄ 1.2g (0.0 01mol)と、例示化合物(X-1)のヨード化物8 4.8g(0.22mol)を加え室温で約6時間攪拌 後、この溶液をTHFと氷冷した3M塩酸300mlの混 合物に注ぎ込んだ。クロロホルムで抽出し飽和重ソウ水 で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過、減圧濃 縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィで精製すると例示化合物(15)を44.5g(収率 60%) で得ることができた。

【0127】実施例20(例示化合物(18)の合成) 1,3,5-トリヨードベンゼン(2,4,6-トリヨードアニリンから合成)45.5g(0.1mol)と例示化合物(IX-8)のボロン酸123.8g(0.33mol)、トリエチルアミン66.8g(0.66mol)、酢酸パラジウム0.67g(0.003mol)、トリーロートリルホスフィン3.0g(0.01mol)およびN,Nージメチルホルムアミド300mlの混合物を100℃で約3時間加熱した。溶媒を減圧留去し、残渣にクロロホルムおよび10%アンモニア水溶液を加えた。有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製することにより、例示化合物(18)を80.0g(収率75%)得た。

【0128】実施例21(例示化合物(8)の合成) 例示化合物(IX-1)のボロン酸28.9g(0.1mol)と例示化合物(X-1)のヨード化物38.5g (0.1mol)を用い実施例13と同様の反応、後処理 を行なうことにより例示化合物(8)を40.2g(収率80%)得ることができた。

【0129】実施例22(例示化合物(25)の合成)例示化合物(X-8)45.7g(0.1mol)とトリメチルシリルクロリド12.0g(0.11mol)をTHF500mlに溶かし、その中に粉末状リチウム金属1.7g(0.25mole)を入れ約2時間加熱還流した。室温に戻した後希塩酸水をゆっくり滴下し、過剰のリチウム金属を分解した。反応液を酢酸エチルで抽出し、後処理し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過、減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフ

ィで精製することにより4, 4' ービスジメチルアミノー4'' ートリメチルシリルトリフェニルアミンを32, 3g (収率80%) 得た。

【0130】4,4′-ビスジメチルアミノ-4″-トリメチルシリルトリフェニルアミン20.2g(0.05mol)と塩化アリルパラジウム二量体183g(0.5mol)のヘキサメチルホスホルアミド(HMPA)溶液(50ml)にトリス(ジメチルアミノ)スルホニウムジフルオロトリメチルシリカート(TASF)THF溶液(1.0M、50ml、0.05mol)を0℃で加えた。次にその中に1,4-ジヨードベンゼン8.2g(0.025mole)を入れ、約50℃で2時間撹拌した。反応液にクロロホルムと水を加え、抽出操作を行い、溶媒を減圧留去後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製することにより例示化合物(25)を13.8g(収率75%)で得た。

【0131】実施例23(例示化合物(28)の合成)例示化合物(X-7)46.1g(0.1mole)とへキサブチルジスタンナン87g(0.15mole)をトルエン100mlに溶かしテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム1.16g(0.001mole)を加え、60℃、72時間攪拌した。反応液をフッ化カリウム水溶液で数回洗い、トリブチルヨードスズを不溶性のトリブチルフルオロスズに変え取り除く。トルエン層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去後残渣をシリカゲルクロマトグラフィで精製すると4-〔ビス(4-ニトロフェニル)アミノ〕フェニルトリブチルスズを53.1g(収率85%)得た。

【0132】ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロリド0.14g(0.2mole)とリチウムクロリド0.64g(15mole)を、4-[ビス(4-ニトロフェニル)アミノ〕フェニルトリブチルスズ22.5g(36mol)と例示化合物X-713.8g(30mol)のトルエン(500ml)溶液に加え、約48時間加熱還流した。通常の後処理後シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、例示化合物(25)を15.8g(収率79%)得ることができた。

[0133]

【発明の効果】本発明の製造方法および合成中間体を用いることにより、有機EL材料、電子写真用材料又は光記録材料用などの近赤外染料用原料として有用な芳香族三級アミン化合物の合成が容易になり、その工業的利用可能性を拡大した。特にこれまで合成が非常に困難であったポリフェニル(トリフェニル、テルフェニルなど)型の芳香族三級アミンが容易に得られるようになった効果は極めて大きい。

【手続補正書】

【提出日】平成8年9月18日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス(EL)材料、又は電子写真用材料、又は光記録材料用などの近赤外染料用原料として有用な芳香族三級アミン化合物の製造方法及びその合成中間体に関する。詳しくは、パラジウム触媒を用いた芳香族基の炭素原子間クロスカップリング反応を用いた分子内に少なくとも2つの芳香族三級アミンを含む化合物の高収率製造方法及び、本製造法に有用な合成中間体に関する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正内容】

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このように、種々の用 途に芳香族第三級アミンは有用な化合物であるが、それ らの中のビフェニル基などを有するポリフェニル系芳香 族第三級アミンの合成方法は、主にウルマン型反応を用 いる方法が常法であった(米国特許4,764,625 号)。この方法は、銅触媒を用い、塩基性条件下でハロ ゲン化アリール(主にヨウ化アリール)とジアリールア ミンを反応させて、炭素-窒素結合を結合させることを 特徴とする。この方法は単純な芳香族第三級アミンを合 成する場合には有効な方法であるが、高温(>160 ℃)かつ、長時間を要する反応であるため、出発物質や 生成物が、熱や塩基に不安定な場合には利用できなかっ た。また一般に反応時間が長い上に収率が低く、高純度 品が得るための精製が容易でないなど生産性の面で低い ことも問題であった。最近城田らは、グリニャール試薬 と二価のニッケル錯体を用いて、芳香族三級アミンを分 子内に有する化合物の合成法を開示しているが(特開平 7-53955号、J.Mater.Chem., 2, 1109 (19 92))ニッケルは近年その発ガン性が問題となってお り、工業的規模での製造では使用しにくい金属触媒であ る。更に近赤外吸収染料用のビフェニル基を有する芳香 族第三級アミンの合成には、強い発ガン性により、製造 禁止物質になっているベンジジンを用いなければならな いことも大きな問題であった(米国特許公報3,48 4,467号、特開平6-321872号)。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正内容】

【0042】Ar3 は1~6価の芳香族基を表わすが、 詳しくは炭素数6~60の炭素環又は複素環芳香族化合 物由来の1~6価の芳香族基を表わす。具体的にはフェ ニル、oー、mー、もしくはpーフェニレン、ベンゼン -1, 3, 5-ル、ナフタレン-1,4-ジイン、ナフタレン-1, 4, 5, 8-テトライル、ペリレン-3, 4, 9, 10 ーテトライル、ビフェニルー4, 4´ージイル、pーテ ルフェニル-4, 4' -ジイル、2, 1': 5', 2''ーテルナフタレンー5,5"ージイル、1,3,5ート・ リフェニルベンゼンー4′,4″,4′′′ートリイ ル、トリフェニルアミンー4,4',4"ートリイルも しくはフェニルー1, 2, 3, 4, 5, 6 - ヘキサイ ル、などの炭素環芳香族基、又は、2-ピリジル、3-ピリジル、4ーピリジル、ピリジン-2,6ージイル、 ピリジンー2,4ージイル、4ーキノリル、ピラジンー 2, 5-ジイル、キノリン-4, 8-ジイル、フェナジ b] チアゾールー3, 5ージイルもしくは、フタラジン -1,4-ジイルなどの複素環芳香族化合物である。好 ましくは1~3価の炭素環芳香族基であり、特に好まし くはフェニル、oー、mーもしくはpーフェニレン、ベ ンゼン-1,3,5-トリイル、ビフェニル-4,4 4″, 4′′′ートリイル、又はトリフェニルアミンー 4,4',4"-トリイルの炭素環芳香族基である。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】X2 はマグネシウム、亜鉛、銅、ホウ素、 アルミニウム、ケイ素又はスズ元素で結合する基を表わ すが、詳しくは-Mg X³、-Zn X⁴、-Cu X⁵、 $-Cu \setminus -B(Y^1)_2 \setminus -Al(Y^2)_2 \setminus Si(Y^3)_3$ 又は $Sn(Y^4)_3$ で表わされる基である。 $X^3 X^4 X^4$ X5 はハロゲン原子を表わし、好ましくは塩素、臭素又 はヨウ素原子を表わし、特に好ましくは塩素又は臭素原 子である。Y¹、Y²、Y³ およびY⁴ はハロゲン原 子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、又 はヒドロキシル基であり、好ましくはフッ素、塩素もし くは臭素原子のハロゲン原子、メチル、エチル、n-ブ チル、もしくはiーブチルのアルキル基、メトキシ、エ トキシ、イソプロピルオキシもしくはエチレンジオキシ のアルコキシ基、フェノキシもしくは1,2-フェニレ ンジオキシのアリールオキシ基又はヒドロキシル基であ る。Y¹ 、Y² 、Y³ およびY⁴ は特に好ましくは塩素 原子、n-ブチル基又はヒドロキシル基である。尚、Y 1 \sim Y 4 は 2 \sim 3 個が各元素に結合するが、それらが常に同一の基であるとは限らず、 1 \sim Y 4 で定義された異なった基が 1 1 \sim O 1 \sim C 1 \sim

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正内容】

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【0056】 R^{11} および R^{14} は水素原子又は低級アルキル基を表わすが、低級アルキル基を詳しく説明すれば $C_1 \sim C_6$ のアルキル基であり、例えばメチル、エチル、nーブチル又はtーブチル基である。 R^{12} および R^{13} は水素原子、低級アルキル基、置換もしくは無置換のフェニル基、低級ジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、低級アルコキシ基又はニトロ基を表わすが、水素原子とニトロ基以外について詳しく説明すれば、メチル、エチル、nーブチル、tーブチルもしくはtnーヘキシルなどの低級アルキル基、フェニル、t0ー、t0ー、t1)

フェニル (pービフェニルイル)、pージエチルアミノフェニルもしくはpーメトキシフェニルなどの置換もしくは無置換フェニル基、ジメチルアミノ、ジエチルアミノもしくはジーnーブチルアミノなどの低級ジアルキルアミノ基、ジフェニルアミノ、Nー(3ーもしくは4ーメチルフェニル)ーNーフェニルアミノ、ビス(4ージエチルアミノフェニル)アミノ、もしくはビス(4ーメトキシフェニル)アミノなどの置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、メトキシ、エトキシ、イソプロボキシ、nーブトキシもしくはシクロヘキシルオキシなどの低級アルコキシ基である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0098

【補正対象項目名】0110

【補正方法】変更

【補正方法】変更

【補正内容】

[0098]

【化29】

【補正内容】

[0110]

【実施例】次に実施例に基づき、本発明の合成方法を詳 しく説明する。

実施例1(例示化合物X-1の合成)

3-メチルジフェニルアミン21.9g(0.1mole) (アルドリッチ社より購入)と4-ヨードニトロベンゼン32.4g(0.13mole)をジメチルホルムアミド500mlに溶かし、その中に銅粉を12.7g(0.2mole)と炭酸カルシウム20.7g(0.15mole)を入れ、100℃で約24時間加熱攪拌した。反応液を水に注ぎ、クロロホルムにて3回抽出し、後処理後濃縮し、残査をカラムクロマトグラフィにて精製すると、3-メチル-4′ーニトロトリフェニルアミンを25.9g(収率85%)得ることができた。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0111

【補正方法】変更

【補正内容】

【0111】得られた3-メチル-4′-ニトロトリフェニルアミン20.0g(0.066mole)を常法により中性鉄還元することにより4-アミノ-3′-メチルトリフェニルアミン17.2g(収率95%)を得た。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0112

【補正方法】変更

【補正内容】

【0112】4ーアミノー3´ーメチルトリフェニルアミン15g(0.055mole)、氷50g、水60mlおよび濃硫酸57ml(0.68mol)をフラスコに入れ、メカニカルスターラーで攪拌した。その中に亜硝酸ナトリウム4.1g(0.060mol)を水55mlに溶かし内温が5℃以上にならない程度の速度で滴下した。滴下終了後約1時間同温で攪拌し、得られたジアゾニウム塩水溶液に、5℃以下でヨウ化カリウム13.5g(0.082mol)の70ml水溶液を30分間で滴下した。滴下後1時間同温で攪拌し、室温に戻して2時間攪拌後反応溶液を酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥(無水硫酸マグネシウム)、溶媒減圧留去した。得られた結晶性化合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、例示化合物(X-1)を20.5g(収率73%)得た。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0118

【補正方法】変更

【補正内容】

【0118】実施例6(例示化合物(IX-2)の合成) 実施例1で得た例示化合物(X-1)20g(52mmo l)をテトラヒドロフラン(THF)200mlに溶かし -78℃に冷却した。その中にnーブチルリチウムの 1.6Mへキサン溶液32ml(52mmol)を滴下した。 滴下後30分間攪拌し、その後、ホウ酸トリメチル5. 4g(52mmol)のTHF溶液を約1時間で滴下した。 1時間攪拌後ゆっくり室温まで温度を上げ、さらに2時間反応させた。次に希硫酸(硫酸12ml+水240ml) を0℃で加え加水分解した。酢酸エチル抽出し、減圧濃縮して得られたボロン酸の固体をトルエン再結により精製すると例示化合物(IX-2)を14.2g(収率90%)得ることができた。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0119

【補正方法】変更

【補正内容】

【0119】実施例7~11(例示化合物(IX-3)(IX-4)(IX-6)、および(IX-8)の合成) 実施例2~5で合成した例示化合物(X-3)(X-4)(X-6)および(X-8)のヨウ化物を用いて実施例6と同様にして、ボロン酸である例示化合物(IX-3)(IX-4)(IX-6)および(IX-8)をそれぞれ88、86、85および、87%の収率で得ることがで

【手続補正12】

きた。

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0121

【補正方法】変更

【補正内容】

【0121】4-ブロモ-4′,4″-ジニトロトリフェニルアミン8.3g(0.02mol)から、n-ブチルリチウムを用いて実施例6と同様にして、4-〔ビス(4-ニトロフェニル)アミノ〕フェニルリチウムのTHF溶液を調製し、-78℃に冷却後、激しく攪拌しながらホウ酸トリメチル2.1g(0.02mole)のTHF溶液を約1時間で滴下した。その後、実施例6と同様の処理を行ない、例示化合物(IX-7)のボロン酸を6.1g(収率80%)得ることができた。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C O 7 C 211/58		8828-4H	C O 7 C 211/58	
211/59		8828-4H	211/59	
213/02		7457-4H	213/02	
217/92		7457-4H	217/92	
C O 7 F 5/02			C O 7 F 5/02	С
// C07B 61/00	300		C O 7 B 61/00	300